



Э Т И К Е Т К А

Микросхема 854МИ2 в металлостеклянном корпусе, предназначенная для применения в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов

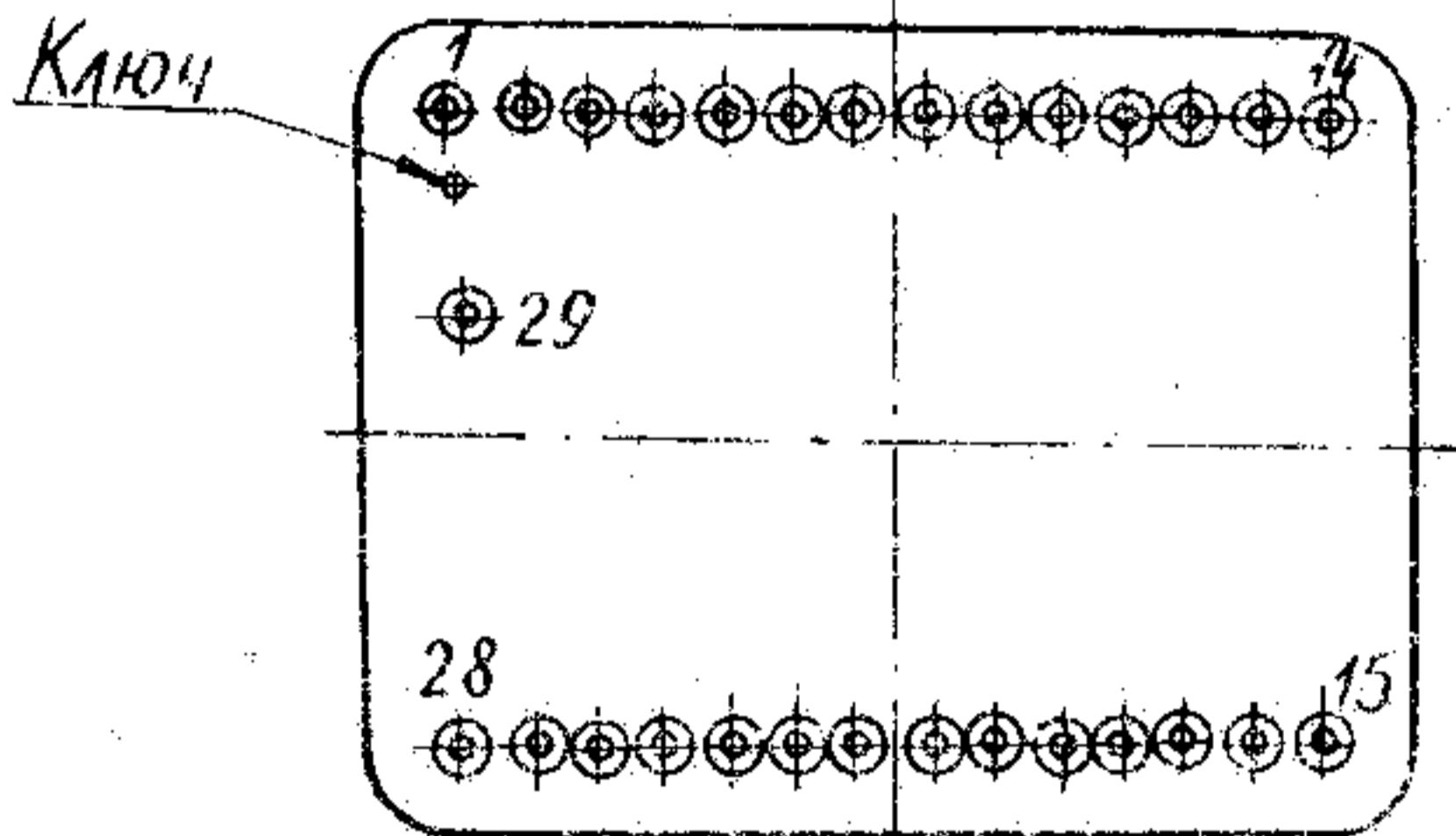


Таблица назначения выводов

Обозначение выводов	Назначение выводов
1	регулировка длительности выбросов
2, 14, 15, 28, 29	корпус
3, 8, 12	минус Δ п
4	регулировка амплитуды импульсов выходного тока
5, 24	установка температурного дрейфа амплитуды импульсов выходного тока
6, 7	установка амплитуды выбросов
9	установка начального тока усилителя отрицательных выбросов
10, 19	установка смещения усилителей тока

Обозначение выводов	!	Назначение выводов
---------------------	---	--------------------

I3	!	выход усилителя отрицательных выбросов
I6	!	выход усилителя положительных выбросов
I7, 21, 22, 23	!" + " Ип	
20	!	установка начального тока усилителя положительных импульсов
26	!	вход
27	!	коррекция входного импульса
II, I8, 25	!	не задействованы

Электрические параметры при поставке, эксплуатации и хранении

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура °C
		не менее	не более	

Максимальное отрицательное напряжение на выходе микросхемы, В	$I_{отр}, mAx$		0,8	25 ± 10
---	----------------	--	-----	-------------

при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$

Диапазон установки амплитуды положительного импульса выходного тока, мА	$\Delta I_{вх}, A$	(I0...I70)		25 ± 10
---	--------------------	------------	--	-------------

при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$,

$I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$,

$I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$,

$\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$,

$Q \geq 2$

Максимальная амплитуда импульса выходного тока, мА	$I_{вх}, A, mAx$	I70	85 ± 3
		I70	минус 60 ± 3
		I70	25 ± 10

при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$,

$I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$,

$I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$,

$\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$,

$Q \geq 2$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а		Температура, °С
		не менее	не более	

Диапазон установки амплитуды выбросов на фронте и срезе импульса выходного тока положительной полярности, мА

25 ± 10

при $I_{\text{вых, A}} = 120$ мА	$\Delta I_{\text{выбр, A, ф}}$	(0...48)		
	$\Delta I_{\text{выбр, A, ср}}$	(0...30)		
при $I_{\text{вых, A}} = 25$ мА	$\Delta I_{\text{выбр, A, ф}}$	(2,5...10)		
	$\Delta I_{\text{выбр, A, ср}}$	(0...6,0)		
при $I_{\text{вых, A}} > 120$ мА	$\Delta I_{\text{выбр, A, ф}}$	(0... $I_{70} - I_{\text{вых, A}}$)		
	$\Delta I_{\text{выбр, A, ср}}$	(0...0,6 x x ($I_{70} - I_{\text{вых, A}}$))		

при: $I_{\text{п}} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$,
 $I'_{\text{вх}} = 2,5 \text{ В}$,
 $I^0_{\text{вх}} \leq 0,6 \text{ В}$,
 $\tau_{\text{вх}} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$,
 $Q \geq 2$

Нестабильность отношения амплитуды выбросов к амплитуде импульса выходного тока в диапазоне температур относительно значения при температуре 25°C , %	$\Delta \frac{I_{\text{выбр, A, ф}}}{I_{\text{вых, A}}}$ отнТ	-35	45	($25 \pm 10 \dots 85 \pm 3$)
Нестабильность отношения амплитуды выбросов к амплитуде импульса выходного тока в диапазоне температур относительно значения при температуре 25°C , %	$\Delta \frac{I_{\text{выбр, A, ср}}}{I_{\text{вых, A}}}$ отнТ	-60	55	($25 \pm 10 \dots 85 \pm 3$)
Нестабильность отношения амплитуды выбросов к амплитуде импульса выходного тока в диапазоне температур относительно значения при температуре 25°C , %	$\Delta \frac{I_{\text{выбр, A, ф}}}{I_{\text{вых, A}}}$ отнТ	-35	30	($25 \pm 10 \dots$ минус 60 ± 3)
Нестабильность отношения амплитуды выбросов к амплитуде импульса выходного тока в диапазоне температур относительно значения при температуре 25°C , %	$\Delta \frac{I_{\text{выбр, A, ср}}}{I_{\text{вых, A}}}$ отнТ	-60	55	($25 \pm 10 \dots$ минус 60 ± 3)

при: $I_{\text{п}} = \pm 6,0 \pm 10\%$,
 $I'_{\text{вх}} = 2,5 \text{ В}$,
 $I^0_{\text{вх}} \leq 0,6 \text{ В}$,
 $\tau_{\text{вх}} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$,
 $Q \geq 2$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а		Температура, °С
		не менее	не более	
Ток смещения, мА	I см	1,4	3,0	$85 \pm 3 \dots 25 \pm 10$
при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$		0,5	2,0	минус $60 \pm 3 \dots 25 \pm 10$
Нестабильность амплитуды импульса выходного тока при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$, %	$\Delta I_{вх}, \text{ А, отн } I_{п}$		10	25 ± 10
при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $U'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $U^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$				
Амплитуда тока помехи при произвольном порядке включения и выключения источников питания, мА	$I_{пом}, \text{ А}$		10	25 ± 10
при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$				
Неравномерность вершины импульса выходного тока, %	$I_{пом}, \text{ отн}$		10	25 ± 10
при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $U'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $U^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$				
Нестабильность отношения амплитуды выброса тока на фронте и срезе к амплитуде импульса тока при изменении И питания в пределах на $\pm 10\%$, %	$\Delta \frac{I_{выбр}, \text{ А, ф}}{I_{вх}, \text{ А}} \text{ отн } U_n - 25$		25	25 ± 10
при: $U'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $U^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$				
	$\Delta \frac{I_{выбр}, \text{ А, ср}}{I_{вх}, \text{ А}} \text{ отн } U_n - 40$		40	

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а		Температура, °C
		не менее	не более	
Входной ток высокого уровня микросхемы, мА при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх} = 4,5 \text{ В}$	$I'_{вх}$		9	25 ± 10
Входной ток низкого уровня микросхемы, мА при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$	$I^0_{вх}$		1,2	25 ± 10
Диапазон регулирования тем- пературного коэффициента амплитуды импульса выходно- го тока, мА/°C при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$	$\Delta I_{вых}, A$	(0,3...2)		минус $60 \pm 3 \dots$ 85 ± 3
Длительность фронта и среза импульса выходного тока по уровню 0,1...0,9 нс при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$	$\tau_{ф,вых}$		3	25 ± 10
			3	минус 60 ± 3
			3	85 ± 3
			3	25 ± 10
			3	минус 60 ± 3
			3	85 ± 3
Диапазон регулирования дли- тельности выбросов на фронте и срезе импульса выходного тока положительной поляр- ности, нс при: $U_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$	$\Delta \tau_{выбр,ф}$ $\Delta \tau_{выбр,ср}$	(5...8)		25 ± 10
		(4,5...7)		25 ± 10

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а		Температура, °C
		не менее	не более	
Изменение длительности импульса выходного тока по сравнению с длительностью запускающего импульса, % при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх1} = 4,5 \text{ В}$, $I'_{вх2} = 2,5 \text{ В}$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 8 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$	$\Delta Z_{вх}, \text{отн}$	-15	22	25 ± 10
Изменение времени задержки $\Delta t_{зд}$, абс интегральной микросхемы в диапазоне температур, нс при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$			I	минус 60 ± 3 ... 25 ± 10 65 ± 3 ... 25 ± 10
Время задержки импульса интегральной микросхемы, нс при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$, $I'_{вх} = 2,5 \text{ В}$, $I^0_{вх} \leq 0,6 \text{ В}$, $\tau_{вх} = 20 \text{ нс} \pm 5\%$, $Q \geq 2$	$t_{зд}$		4	25 ± 10
Ток потребления в стати- ческом режиме по положи- тельному источнику пита- ния, мА при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$	$I^+_{пот.стат.}$		66	25 ± 10
Ток потребления в стати- ческом режиме по отрица- тельному источнику питания, мА при: $I_{п} = \pm 6,0 \text{ В} \pm 10\%$	$I^-_{пот.стат.}$		50	25 ± 10

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	: Буквенное : обозначение :	: Н о р м а		: Температура, °C
		: не : менее	: не : более	
Ток потребления в динамическом режиме по положительному источнику питания, мА при: Ип = ±6,0 В ± 10 % И вх = 2,5 В И ⁰ вх ≤ 0,6 В τ вх = 14,5 нс ± 10% Q = 2	I ⁺ пот. дин.	170		25 ± 10
Ток потребления в динамическом режиме по отрицательному источнику питания, мА при: Ип = ±6,0 В ± 10% И вх = 2,5 В И ⁰ вх ≤ 0,6 В τ вх = 14,5 нс ± 10% Q = 2		85		25 ± 10

Примечание. I^I в_{ых}, А — максимальная амплитуда импульса тока в рабочем диапазоне температур 85°C ... минус 60°C.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ

Золото - 0.0382 г;
Серебро - 0.0468 г;
Платина - 0.0208 г;
Палладий - 0.0001 г;

В том числе:

золото 0.0169 г/мм на 28 выводах длиной 7 мм

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 854 МИ 2 соответствуют техническим условиям
ОК0.347.353 - 03 ТУ.

Приняты по извещению № 1695 от 13 ИЮН 1989
дата

Штамп ОТК



Штамп представителя
заказчика



Штамп "Перепроверка произведена _____"
дата

Приняты по извещению № _____ от _____
дата

Штамп ОТК

Штамп представителя
заказчика